

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-77593

(P2000-77593A)

(43) 公開日 平成12年3月14日 (2000.3.14)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	ノート* (参考)
H 0 1 L 23/50		H 0 1 L 23/50	D 4 K 0 2 4
C 2 5 D 5/12		C 2 5 D 5/12	5 F 0 6 7
7/12		7/12	

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号	特願平10-241457	(71) 出願人	000005120 日立電線株式会社 東京都千代田区大手町一丁目6番1号
(22) 出願日	平成10年8月27日 (1998.8.27)	(72) 発明者	秋野 久則 茨城県土浦市木田余町3550番地 日立電線株式会社システムマテリアル研究所内
		(72) 発明者	珍田 聡 茨城県土浦市木田余町3550番地 日立電線株式会社システムマテリアル研究所内
		(74) 代理人	100100240 弁理士 松本 孝

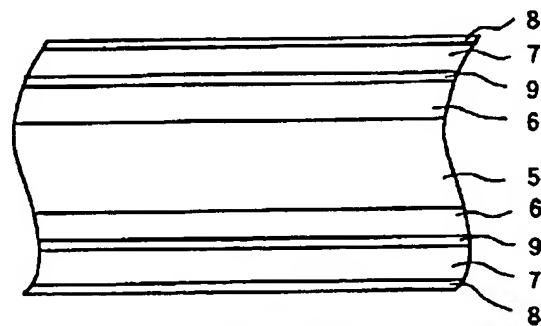
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体用リードフレーム

(57) 【要約】

【課題】半導体用リードフレームの加熱後のはんだ付け性、W/B性を優れたものにする。

【解決手段】銅合金から成るリードフレーム基材5上の全面にニッケルめっき膜6、パラジウムめっき膜7、金フラッシュめっき膜8を形成するリードフレームにおいて、ニッケルめっき膜6とパラジウムめっき膜7の中間にニッケル合金めっき膜9を形成し、4層構造めっきの半導体用リードフレーム1とする。



6 : N i めっき膜
7 : P d めっき膜
8 : A u フラッシュめっき膜
9 : N i 合金めっき膜

PAT-NO: JP02000077593A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000077593 A

TITLE: LEAD FRAME FOR SEMICONDUCTOR

PUBN-DATE: March 14, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
AKINO, HISANORI	N/A
CHINDA, SATOSHI	N/A
TOMOBE, MASAKATSU	N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
HITACHI CABLE LTD	N/A

APPL-NO: JP10241457

APPL-DATE: August 27, 1998

INT-CL (IPC): H01L023/50, C25D005/12, C25D007/12

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a lead frame for semiconductor which is superior in solderability after heating and W/B properties.

SOLUTION: A lead frame having a nickel plating film 6, a palladium plating.

film 7 and a gold flash plating film 8 formed on the entire surface of a lead frame basic material 5 of copper alloy is further provided with a nickel alloy plating film between the nickel plating film 6 and the palladium plating film 7, thus obtaining a four-layer structure plated lead frame for semiconductor.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO